

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60947-5-2

1997

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
1999-06

Amendement 1

Appareillage à basse tension –

**Partie 5-2:
Appareils et éléments de commutation
pour circuits de commande –
DéTECTEURS DE PROXIMITÉ**

Amendment 1

Low-voltage switchgear and controlgear –

**Part 5-2:
Control circuit devices and switching elements –
Proximity switches**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

K

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 17B: Appareillage à basse tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
17B/981/FDIS	17B/993/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 8

1.1 Domaine d'application et objet

Remplacer le premier alinéa existant par le suivant:

La présente partie de la CEI 60947 s'applique aux détecteurs de proximité inductifs et capacitifs qui détectent la présence d'objets métalliques et/ou non métalliques, aux détecteurs de proximité ultrasoniques qui détectent la présence d'objets réfléchissants les ultrasons, aux détecteurs de proximité photoélectriques qui détectent la présence d'objets et aux détecteurs de proximité magnétiques non mécaniques qui détectent la présence d'objets avec un champ magnétique.

Page 12

Ajouter, après « Détecteur de proximité inductif », la nouvelle définition suivante:

Détecteur de proximité magnétique non mécanique2.1.1.5

Page 16

Ajouter, après 2.1.1.4, la nouvelle définition suivante:

2.1.1.5

détecteur de proximité magnétique non mécanique

détecteur de proximité qui détecte la présence d'un champ magnétique et qui possède un élément de commutation à semi-conducteur mais pas de partie mobile dans l'élément sensible

2.2.2.1

axe de référence pour les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et ultrasoniques

Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant:

2.2.2.1

axe de référence pour les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs, magnétiques non mécaniques et ultrasoniques

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
17B/981/FDIS	17B/993/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 9

1.1 Scope and object

Replace the existing first paragraph by the following:

This part of IEC 60947 applies to inductive and capacitive proximity switches that sense the presence of metallic and/or non-metallic objects, ultrasonic proximity switches that sense the presence of sound reflecting objects, photoelectric proximity switches that sense the presence of objects and non-mechanical magnetic proximity switches that sense the presence of objects with a magnetic field.

Page 13

Add, after “Non-embeddable proximity switch”, the following new definition:

Non-mechanical magnetic proximity switch2.1.1.5

Page 17

Add, after 2.1.1.4, the following new definition:

2.1.1.5

non-mechanical magnetic proximity switch

proximity switch which senses the presence of a magnetic field and has a semiconductor switching element and no moving parts in the sensing element

2.2.2.1

reference axis for inductive, capacitive and ultrasonic proximity switches

Replace the existing title by the following new title:

2.2.2.1

reference axis for inductive, capacitive, non-mechanical magnetic and ultrasonic proximity switches

Page 18

Ajouter, après 2.2.11.3, la nouvelle définition suivante:

2.2.11.4

face sensible d'un détecteur de proximité magnétique non mécanique

une surface du détecteur de proximité, à travers laquelle le changement d'un champ magnétique est détecté

Page 28

Tableau 1

Ajouter, dans la colonne 1, ce qui suit:

M = magnétique non mécanique

Page 42

6.1.1.1 Détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et ultrasoniques

Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant:

6.1.1.1 Détecteurs de proximité inductifs, capacitifs, magnétiques non mécaniques et ultrasoniques

Page 54

Ajouter, après 7.2.1.3.4, le nouveau paragraphe suivant:

7.2.1.3.5 Sensibilité et portées des détecteurs de proximité magnétiques non mécaniques

Pour les détecteurs de proximité magnétiques non mécaniques, les caractéristiques de la portée et les tolérances doivent être déclarées par le constructeur.

7.2.1.6.1 Détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et ultrasoniques

Remplacer «...et doit être mesurée conformément à 8.5.» par «... et doit être mesurée conformément à 8.5.1 et 8.5.2.»

7.2.1.6.2 Détecteurs de proximité photoélectriques

Ajouter, à la fin de ce paragraphe, la nouvelle phrase suivante:

t_{on} et t_{off} doivent être mesurés conformément à 8.5.3.

Page 19

Add, after 2.2.11.3, the following new definition:

2.2.11.4

sensing face of a non-mechanical magnetic proximity switch

a surface of the proximity switch through which the change in a magnetic field is detected

Page 29

Table 1

Add, in column 1, the following:

M = non-mechanical magnetic

Page 43

6.1.1.1 Inductive, capacitive and ultrasonic proximity switches

Replace the existing title by the following new title:

6.1.1.1 Inductive, capacitive, non-mechanical magnetic and ultrasonic proximity switches

Page 55

Add, after 7.2.1.3.4 the following new subclause:

7.2.1.3.5 Sensitivity and operating distances of non-mechanical magnetic proximity switches

For non-mechanical magnetic proximity switches, the operating sensing characteristics and their tolerances shall be declared by the manufacturer.

7.2.1.6.1 Inductive, capacitive and ultrasonic proximity switches

Replace " ... and shall be measured according to 8.5." by "... and shall be measured according to 8.5.1 and 8.5.2."

7.2.1.6.2 Photoelectric proximity switch

Add, at the end of this subclause, the following new sentence:

t_{on} and t_{off} shall be measured according to 8.5.3.

Page 66

7.4.2 Vibrations

Remplacer le troisième alinéa existant par le suivant:

Amplitude 1 mm pour les détecteurs de proximité inductifs, capacitifs, magnétiques non mécaniques et ultrasoniques
0,5 mm pour les détecteurs de proximité photoélectriques

Page 72

Ajouter, après 8.3.2.1.3, le nouveau paragraphe suivant:

8.3.2.1.4 Cible normalisée pour les détecteurs de proximité magnétiques non mécaniques

Pour les détecteurs de proximité magnétiques non mécaniques, la cible doit être spécifiée par le constructeur.

Page 86

8.4.1 Détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et ultrasoniques

Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant:

8.4.1 Détecteurs de proximité inductifs, capacitifs, magnétiques non mécaniques et ultrasoniques

Page 94

Figure 12 – Méthodes de mesure de la fréquence de commutation f des détecteurs de proximité inductifs et capacitifs

Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant:

Figure 12 – Méthodes de mesure de la fréquence de commutation des détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et magnétiques non mécaniques (si applicable)

8.5 Essai pour la fréquence de commutation

Ajouter, avant 8.5.1, le nouvel alinéa suivant:

Lorsque la fréquence de commutation du détecteur de proximité dépasse les limites de la méthode de mesure décrite, le constructeur doit indiquer la méthode de mesure.

8.5.1 Méthode de mesure de la fréquence de commutation

Remplacer le titre existant de a) par le suivant:

a) Détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et magnétiques non mécaniques

Supprimer, en a), la note.

Page 67

7.4.2 Vibration

Replace the existing third paragraph by the following:

Amplitude	1 mm for inductive, capacitive, non-mechanical magnetic and ultrasonic proximity switches
	0,5 mm for photoelectric proximity switches

Page 73

Add, after 8.3.2.1.3, the following new subclause:

8.3.2.1.4 Standard target for non-mechanical magnetic proximity switch

For non-mechanical magnetic proximity switches the target shall be specified by the manufacturer.

Page 87

8.4.1 Inductive, capacitive and ultrasonic proximity switches

Replace the existing title by the following new title:

8.4.1 Inductive, capacitive, non-mechanical magnetic and ultrasonic proximity switches

Page 95

Figure 12 – Methods for measuring the operating frequency f , inductive and capacitive proximity switches

Replace this title by the following new title:

Figure 12 – Methods for measuring the operating frequency of inductive, capacitive and non-mechanical magnetic proximity switches (if applicable)

8.5 Testing for the frequency of operating cycles

Add, before 8.5.1, the following new paragraph:

When the proximity switch frequency of operating cycles exceeds the limit of the measuring method described, the manufacturer shall state the method of measurement.

8.5.1 Method for measuring the frequency of operating cycles

Replace the existing title of a) by the following:

a) Inductive, capacitive and non-mechanical magnetic proximity switches

Delete, in a), the note.

Ajouter, après 8.5.2, le nouveau paragraphe suivant:

8.5.3 Détecteurs de proximité photoélectriques

8.5.3.1 Moyens de mesure

Comme le montre la figure 15, un disque tournant comportant une ou plusieurs cibles est fixé parallèlement à la face sensible du détecteur de proximité à une distance inférieure à 10 cm, et de façon que l'axe de référence du détecteur de proximité passe au centre de la cible.

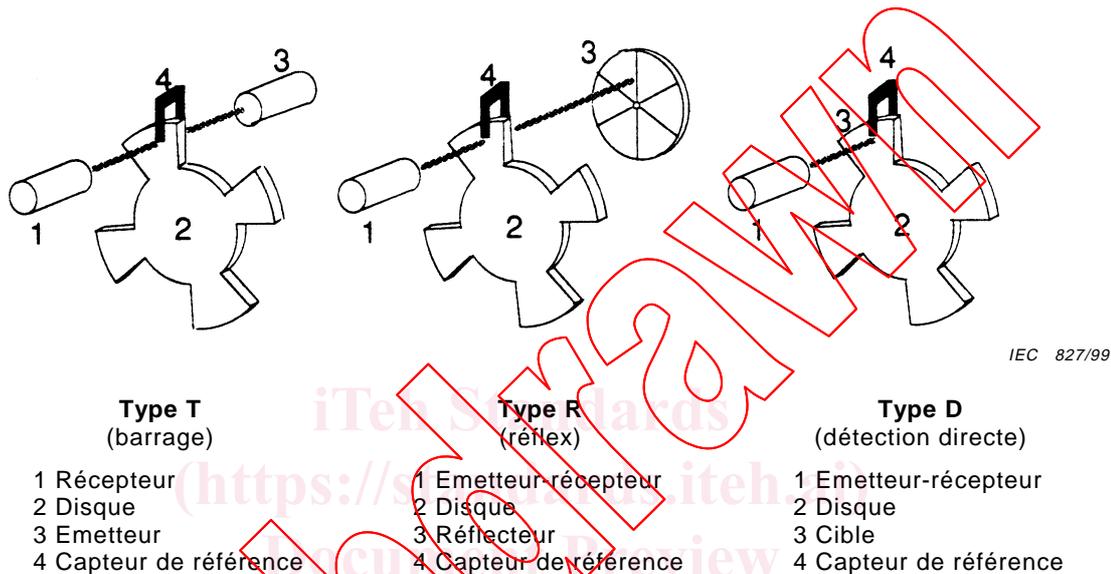


Figure 15 – Moyen de mesure des temps d'action t_{on} et de relâchement t_{off}

Pour les types T et R, le faisceau efficace doit être complètement obstrué par la cible tournante.

Pour le type D, la surface de la cible tournante doit être faite du même matériau que la cible normalisée.

Si la distance de détection affecte les essais, le constructeur doit définir la distance d'essai.

Un capteur de référence ayant une fréquence de commutation au moins dix fois plus grande que l'appareil à l'essai (EUT) est aussi placé à proximité du disque.

Un enregistreur (par exemple un oscilloscope à mémoire) peut tracer simultanément les courbes délivrées par le détecteur de proximité et par le capteur de référence (voir figures 16 et 17).

8.5.3.2 Mesure du temps d'action (t_{on})

La position relative du capteur de référence et de l'EUT doit être ajustée en déplaçant lentement le disque de façon que les sorties du capteur de référence et de l'EUT changent d'état simultanément.

Pour mesurer t_{on} , la vitesse du disque est ajustée de façon que l'EUT fonctionne approximativement à la moitié de la fréquence de fonctionnement maximale définie par le constructeur.

Add, after 8.5.2, the following new subclause:

8.5.3 Photoelectric proximity switches

8.5.3.1 Measurement means

As shown in figure 15, a rotating disc with one or more targets is fixed parallel to the sensing face of the proximity switch at a distance less than 10 cm, and in such a way that the reference axis of the proximity switch passes through the centre of the target.

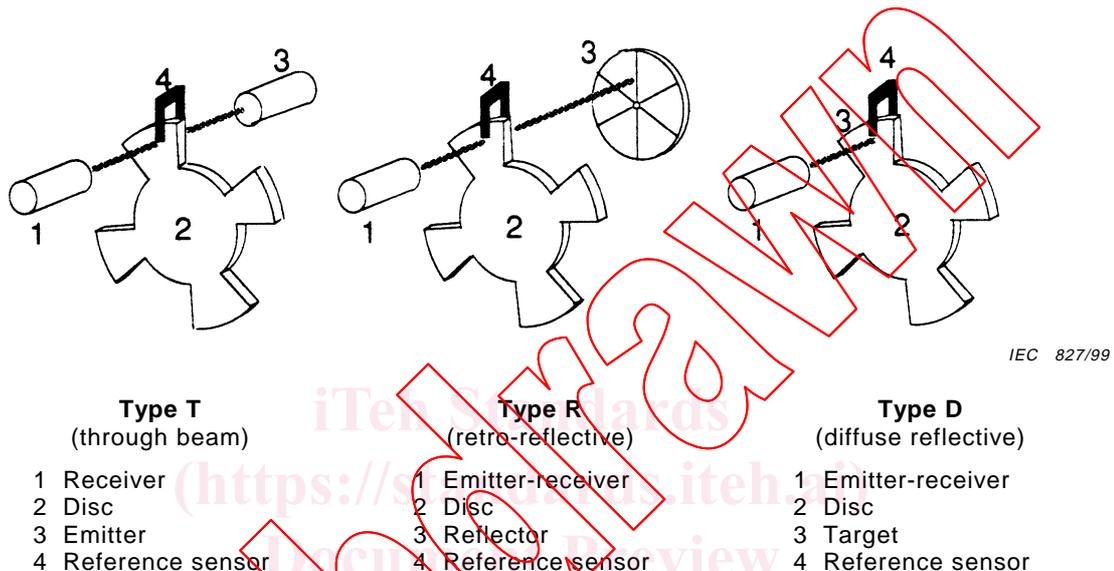


Figure 15 – Measurement means for turn-on time t_{on} and turn-off time t_{off}

For types T and R, the effective beam shall be fully broken by the rotating target.

For type D, the surface of the rotating target shall be made of the same material as the standard target.

If the operating distance affects the tests, then the manufacturer shall state the test distance.

A reference sensor having a switching frequency at least ten times higher than the equipment under test (EUT) is also put around the disc.

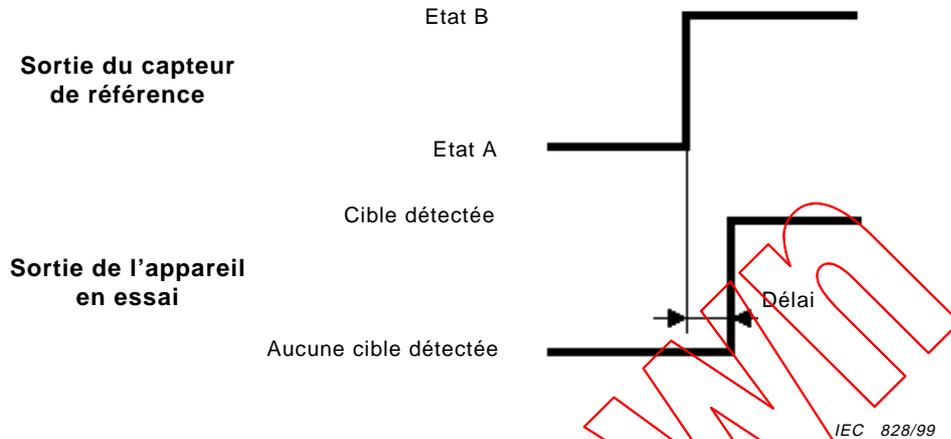
A recorder (for example, a memory oscilloscope) can draw simultaneously curves delivered by the proximity switch and by the reference sensor (see figures 16 and 17).

8.5.3.2 Measurement of turn-on time (t_{on})

The positional relationship between the reference sensor and the EUT shall be adjusted while moving the disc slowly so that the output of the reference sensor changes its state simultaneously with the output of the EUT.

To measure t_{on} , the disc speed is adjusted so that the EUT is operated at approximately half of the maximum operating frequency stated by the manufacturer.

Le temps d'action t_{on} est le délai maximal observé entre la sortie du capteur de référence et le changement d'état de la sortie de l'EUT (voir figure 16).



NOTE – Le schéma se rapporte aux états logiques A et B. A et B diffèrent suivant le type de détecteur de proximité.

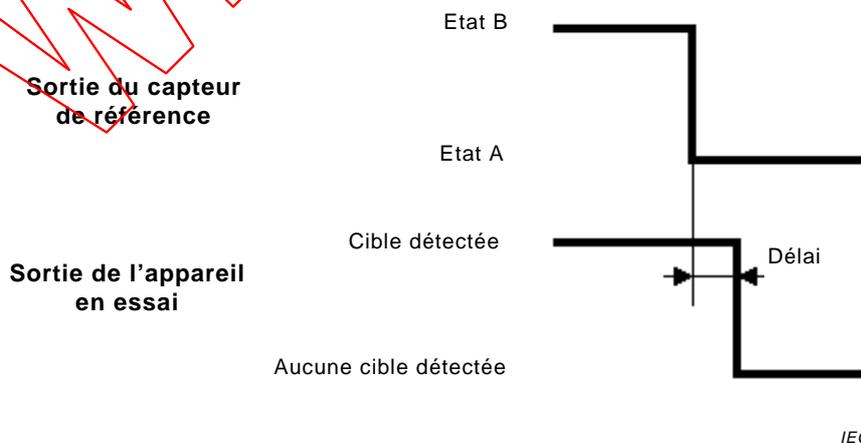
Figure 16 – Mesure du temps d'action t_{on}

8.5.3.3 Mesure du temps de relâchement (t_{off})

La position relative du capteur de référence et de l'EUT doit être ajustée en déplaçant lentement le disque de façon que les sorties du capteur de référence et de l'EUT changent d'état simultanément.

Pour mesurer t_{off} , la vitesse du disque est ajustée de façon que l'EUT fonctionne approximativement à la moitié de la fréquence de fonctionnement maximale définie par le constructeur.

Le temps de relâchement t_{off} est le délai maximum observé entre la sortie du capteur de référence et le changement d'état de la sortie de l'EUT (voir figure 17).



NOTE – Le schéma se rapporte aux états logiques A et B. A et B diffèrent suivant le type de détecteur de proximité.

Figure 17 – Mesure du temps de relâchement t_{off}